

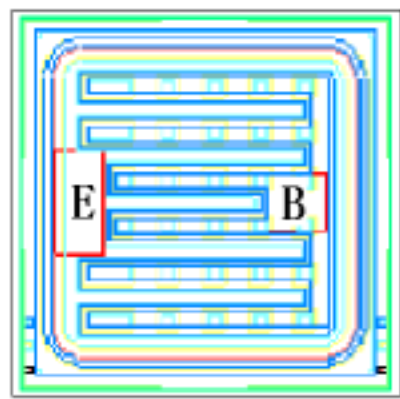


2383 晶体管芯片说明书

■ 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C080BJ-01
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：800×800μm²
焊位尺寸：B 极 124×124μm²；E 极 221×110μm²
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：2SC2383

■ 管芯示意图



■ 极限值 (T_a=25°C) (TO-92L)

T_{stg}——贮存温度……………-55~150°C
T_j——结温……………150°C
P_C——集电极功率耗散 (T_a=25°C) ……900mW
V_{CBO}——集电极—基极电压……………160V
V_{CEO}——集电极—发射极电压……………160V
V_{EBO}——发射极—基极电压……………6V
I_C——集电极电流……………1A
I_B——基极电流……………0.5A

■ 电参数 (T_a=25°C) (TO-92L)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	160			V	I _C =100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	160			V	I _C =10mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	I _E =100μA, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			1	μA	V _{CB} =150V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			1	μA	V _{EB} =6V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	60		320		V _{CE} =5V, I _C =200 mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			1.5	V	I _C =500mA, I _B =50mA
V _{BE(on)}	基极—发射极饱和电压	0.45		0.75	V	V _{CE} =5V, I _C =5mA
f _T	特征频率	20	100		MHz	V _{CE} =5V, I _C =200mA
C _{ob}	共基极输出电容			20	pF	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1MHz